

# 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）



|  |  |
|--|--|
| 代理人<br>前田 弘<br>様                                 |  |
| あて名<br>〒541-0053<br>日本国大阪府大阪市中央区本町2丁目5番7号 大阪丸紅ビル |  |

PCT  
国際調査機関の見解書  
(法施行規則第40条の2)  
[PCT規則43の2.1]

発送日  
(日.月.年) 04.10.2005

|  |                             |                           |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| 出願人又は代理人<br>の書類記号 M05-W-177CT1                     | 今後の手続きについては、下記2を参照すること。     |                           |
| 国際出願番号<br>PCT/JP2005/011825                        | 国際出願日<br>(日.月.年) 28.06.2005 | 優先日<br>(日.月.年) 07.07.2004 |
| 国際特許分類 (IPC) Int.Cl.7 H01L27/146, 21/76, H04N5/335 |                             |                           |
| 出願人（氏名又は名称）<br>松下電器産業株式会社                          |                             |                           |

1. この見解書は次の内容を含む。

- 第I欄 見解の基礎
- 第II欄 優先権
- 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- 第IV欄 発明の單一性の欠如
- 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- 第VI欄 ある種の引用文献
- 第VII欄 国際出願の不備
- 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

Post Available Copy

|  |                           |    |      |
|--|---------------------------|----|------|
| 見解書を作成した日<br>16.09.2005  | 特許庁審査官（権限のある職員）<br>恩田 春香  | 4L | 8934 |
| 名称及びあて先<br>日本国特許庁 (ISA/JP)<br>郵便番号 100-8915<br>東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 | 電話番号 03-3581-1101 内線 3498 |    |      |

## 第I欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

この見解書は、\_\_\_\_\_語による翻訳文を基礎として作成した。  
それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、  
以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ  配列表

配列表に関連するテーブル

b. フォーマット  書面

コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期  出願時の国際出願に含まれる

この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された

出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3.  さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

|                 |                      |   |
|-----------------|----------------------|---|
| 新規性 (N)         | 請求の範囲 <u>8-10</u>    | 有 |
|                 | 請求の範囲 <u>1-7, 11</u> | 無 |
| 進歩性 (I S)       | 請求の範囲 <u>9, 10</u>   | 有 |
|                 | 請求の範囲 <u>1-8, 11</u> | 無 |
| 産業上の利用可能性 (I A) | 請求の範囲 <u>1-11</u>    | 有 |
|                 | 請求の範囲 _____          | 無 |

## 2. 文献及び説明

文献1: JP 62-86756 A (新技術開発事業団外2名)

1987.04.21, 全文, 第1-2図

文献2: JP 1-161757 A (日本電気株式会社) 1989.06.26,  
全文, 第1図

文献3: JP 61-141175 A (浜松ホトニクス株式会社)  
1986.06.28, 全文, 第1-2図

文献4: JP 2004-172394 A (株式会社ニコン)  
2004.06.17, 全文

文献5: JP 2001-085658 A (ソニー株式会社)  
2001.03.30, 段落【0091】図12

文献6: JP 2002-270808 A (松下電器産業株式会社)  
2002.09.20, 段落【0001】【0037】図1 (b)

文献7: JP 5,3-148394 A (富士通株式会社) 1978.12.23,  
全文, 第1-2図

文献8: JP 63-058852 A (沖電気株式会社) 1988.03.14,  
全文, 第1図, 第3図

文献9: JP 52-86782 A (日本電気株式会社) 1977.07.19,  
全文, 第2図

請求の範囲1-3, 5, 7に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1に、請求の範囲1-3, 5, 7, 11に係る発明は、国際調査報告で引用された文献2に、請求の範囲1, 2, 5, 7に係る発明は、国際調査報告で引用された文献3に、請求の範囲1, 2, 4-7に係る発明は、国際調査報告で引用された文献4にそれぞれ記載されているので、請求の範囲1-7, 11に係る発明は新規性、進歩性を有しない。

請求の範囲4に係る発明は、文献1、文献2、文献4、国際調査報告で引用された文献5とにより進歩性を有しない。文献4には、トレンチ分離領域の溝の内壁に拡散層が形成されることが、文献5の段落【0091】には、素子分離領域65の周囲にn型不純物領域67が形成されていることが記載されている。

## 第VII欄 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

請求の範囲 1 に記載された「素子分離材料材料」は誤記である。

## 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

請求の範囲 6 に係る発明は、文献 1、文献 2、国際調査報告で引用された文献 6 とにより進歩性を有しない。文献 6 の段落【0037】には、「分離拡散領域 19 としては、n チャンネル MOS トランジスタ同士を分離する場合は p 型拡散領域が用いられ」と記載されている。

請求の範囲 8 に係る発明は、文献 2、文献 3、文献 4、文献 5、国際調査報告で引用された文献 9 とにより進歩性を有しない。

請求項 8 に係る発明の「前記素子分離溝の底面及び側壁に不純物を注入する工程」については文献 5 を、「前記素子分離溝の底面及び側壁を覆う絶縁膜を形成する工程」、「前記絶縁膜を形成した後、前記素子分離溝をシリコン層により埋め込む工程」については文献 2、文献 9 を参照されたい。「前記シリコン層の所定の領域に不純物を注入する工程」については文献 3、文献 4、文献 9 を参照されたい。文献 3、文献 4、文献 9 には不純物を含むシリコン層を形成する工程が記載されており、不純物を含むシリコン層を、不純物を注入する工程を採用することで得ることが当業者にとって格別困難であるとは認められない。

請求の範囲 11 に係る発明は、文献 1、文献 4、文献 6 とにより進歩性を有しない。文献 6 の段落【0001】には、「本発明は、デジタルカメラ等に使用されるMOS型撮像装置に関するものである。」と記載されている。